

物理電子システム創造専攻
平成18年度 修士構想発表会プログラム(案) ver.4.5

2006年12月21日版

会場: J2-J232

2006年12月21日

時間: 発表6分+質疑6分(中間8分+7分)

開始時間	研究室	名前	題名	審査員	司会
9:00	渡辺研	鈴木 雄介	Si基板上弗化物系共鳴トンネルダイオードの高品質結晶成長に関する研究		安念
9:12	渡辺研	糸井 正也	Si基板上CdF ₂ /CaF ₂ 量子カスケードレーザの導波路構造に関する研究		
9:24	渡辺研	和田 宇史	弗化物系共鳴トンネルダイオードのSi基板上集積構造に関する研究		
9:36	渡辺研	藤久 雄己	弗化物系サブバンド間遷移レーザの高品質活性層の形成に関する研究		鈴木
9:48	浅田研	竹内 淳	2次元電子ガスを用いた半導体クライストロンに関する研究		
10:00	浅田研	辰尾 佳彦	ショットキーバリアダイオードと広帯域アンテナを用いたTHz帯検出素子に関する研究		
10:12	浅田研	岸本 直道	スペーサー層による共鳴トンネルダイオードTHz発振素子の高周波化		
10:24	休憩				
10:40	小山研	竹石 知史	ナノインプリント技術を用いた中空導波路光デバイスの研究		竹内
10:52	小山研	黒木 圭介	低群速度光伝播を利用した小型光変調器とその集積化に関する研究		
11:04	納富・小山研	近森 峻	フォトニック結晶結合共振器による光制御の研究		
11:16	宮本研	中島 浩	トンネル注入レーザの発振メカニズム解明と動作特性向上に関する研究		
11:28	宮本研	仁科 友宏	アレイレーザを用いた時空間位相同期レーザに関する研究		竹石
11:40	大見研	野武 幸輝	SBSI技術によるSOI/BOX層の均一形成に関する研究		
11:52	大見研	高 峻	せり上げPtSiサリサイドにおける仕事関数制御とSOI-MISFETの作製		
12:04	大見研	仲野 雄介	ECRプラズマプロセスによる極薄HfO ₂ ゲート絶縁膜の形成とデバイス応用		
12:16	休憩				
13:30	半那研	細井 勉	反応性熱CVD poly-SiGe大面積薄膜の特性向上		野武
13:42	半那研	中村 司	液晶性有機半導体の電荷輸送に与えるダイポールの影響		
13:54	高田・半那	常多 真那美	液晶性有機半導体ポリマーの合成と電気的物性評価		
14:06	谷・半那研	絹川 大	液晶性有機半導体/電極系の電荷移動の機構解明と制御		細井
14:18	半那研	下平 善樹	Si ₂ H ₆ -GeF ₄ 系反応性熱CVD法による多結晶SiGe膜の大面積化		
14:30	半那研	塩見 晋章	液晶性有機半導体を用いた有機EL素子の研究		
14:45	休憩				
14:57	筒井研	渡邊 将光	プラズマドーピングで形成するp+極浅領域のキャリア活性化に関する研究		絹川
15:09	筒井研	大川 峰司	弗化物共鳴トンネルダイオードにおける特性不安定現象の解明と安定化策の研究		
15:21	筒井研	渡邊 敬仁	弗化物共鳴トンネルダイオードとSi-MOSFETのモノリシック集積プロセスの研究		
15:33	石原研	安念 一規	C60フラレーンを用いた強誘電体ゲートトランジスタの作製と評価		
15:45	石原研	李 月剛	2T型強誘電体メモリの作製及び評価に関する研究		
15:57	有本・石原研	池田 武嗣	MFIS-FETを用いたNAND型FeRAMのディスタープに関する研究		渡邊将
16:09	石原研	高下 裕一郎	強誘電体ゲートカーボンナノチューブトランジスタの作製と評価		
16:21	石原研	岡沢 昂	強誘電体トランジスタの低電圧化に関する研究		
16:33	石原研	中間 Zhong Zhiyong	Research on BiFeO ₃ Films Used for Ferroelectric Memories		
18:00	懇親会				
19:00	終了				

物理電子システム創造専攻 平成18年度 修士構想発表会プログラム(案) ver.4.5

*一貫：博士一貫コース志望

会場：J2-J233

2006年12月21日

時間：発表6分+質疑6分(中間8分+7分)

開始時間	研究室	名前	題名	審査員	司会
9:00	岩井研	佐藤 創志	A Study on Nitride Incorporated Rare Earth Oxides for Thermal Endurance		福田
9:12	岩井研	一貫 川那子 高暢	A Study on Composite High-k Gate Oxides for Improving Mobility		
9:24	岩井研	足立 学	A study on Metal/High-k gate stack with Fermi Level pinning free structure		佐藤創
9:36	岩井研	両角 康宏	A Study on Structural Dependency of Ballistic Transport in Scaled MOSFET by Numerical Calculation		
9:48	岩井研	大石 善久	A Study on Effective Workfunction Control by Additional Metal Insertion for Schottky-Barrier MOSFET		
10:00	休憩				
10:15	青柳研	大石 真	深紫外LEDのための高濃度高品質p型AlGaIn層の作製		大石善
10:27	青柳研	前川 倫宏	AlGaIn系高効率深紫外発光素子の開発に関する研究		
10:39	青柳研	大塚 匠	AlGaIn深紫外縦型LEDの開発		
10:51	青柳研	柴田 大輔	有機トランジスタにおける接触抵抗の低減		
11:02	青柳研	巻幡 光俊	カーボンナノチューブ・GaAsハイブリッドデバイスの作製と評価		大石真
11:14	梶川研	井上 真理子	プラスチック光ファイバー表面プラズモンバイオセンサ		
11:26	梶川研	大野 泰明	光ナノアンテナによる散乱光測定		
11:38	梶川研	鳥井原 匡	超薄膜グレーティングの表面プラズモン励起		
11:50	休憩				
13:06	伊藤研	佐藤 峰斗	近接場光レンズを用いた原子のナノフォーカシングに関する研究		井上
13:18	伊藤研	棗田 昌尚	2軸bow-tie構造を用いた原子の近接場光トラップに関する研究		
13:30	徳光研	佐藤 崇	酸化物チャネル薄膜トランジスタの高性能化に関する研究		
13:42	徳光研	柴田 宏	金属/絶縁体/強誘電体/絶縁体/半導体(MIFIS)構造を用いた強誘電体		
13:54	徳光研	加藤 潤	低温堆積膜をゲート絶縁膜に用いたSiCパワーMOSFETに関する研究		
14:06	宗片研	行田 裕一	Fe-GaAs系円偏光発光素子の作製と評価		佐藤崇
14:18	宗片研	能政 広毅	InMnAs多層膜構造の作製と評価		
14:30	宗片研	野村 健太	走査型磁気光学顕微鏡による光誘起磁化の研究		
14:42	宗片研	鏝水 将志	強磁性半導体を活用した直線偏光検出素子の作製と評価		
14:54	休憩				
15:10	小林研	野口 博和	高速ビット波長転写による全光シリアル/パラレル変換		行田
15:22	小林研	坂巻 常治	面発光レーザと面型変調器のモノリシック集積に関する研究		
15:34	植之原研	鈴木 昌弘	光信号誤り訂正に関する研究		
15:46	益研	福田 聡	広帯域RF CMOS低雑音増幅器の研究		
15:58	益研	富 万林	高密度多層伝送線路配線構造の研究		野口
16:10	益研	大橋 一磨	広帯域電圧制御RF CMOS発振器に関する研究		
16:22	益研	萩原 汐	統計的解析手法によるCMOS LSI電源最適化の研究		
16:34	益研	石井 隆宏	差動伝送線路によるオンチップグローバル配線の研究		
18:00	懇親会				
19:00	終了				